Catálogo de produtos

Amplificadores de potência de estado sólido

Amplificadores de potência de estado sólido usam semicondutores RF para gerar potência de transmissão sem estágios valvulados. São usados em transmissores de comunicação, canais de radar, plataformas de teste RF e subsistemas de micro-ondas.



Produtos: 21

Revisão: 14 · Data da revisão: 2026-11-12



LCPAM-2000-6000-100-485

Módulo amplificador de potência RF GaN de banda larga, 2–6 GHz, 100 W

O LCPAM-2000-6000-100-485 é um módulo amplificador RF de alta potência e banda larga com tecnologia GaN para 2–6 GHz. A potência de saída saturada típica é de 100 W, com ganho típico de 50 dB. Opera com 24–32 VDC e inclui interface RS-485, monitoramento de estado e desligamento de proteção. Pode ser avaliado como estágio de potência em sistemas RF de 50 Ω.

Frequência de operação: Símbolo: BW; Mínimo: 2000; Máximo: 6000; Unidade: MHz

Potência RF de saída saturada: Símbolo: Pout; Típico: 100; Unidade: W

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 50; Unidade: dB

Tensão de operação: Símbolo: VDC; Mínimo: 24; Típico: 28; Máximo: 32; Unidade: VDC

Salvo indicação em contrário: +28,0 VDC, 25 °C, sistema de 50 Ω

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCPAM-100-18000-5

Amplificador de potência GaN RF de 100–18000 MHz, mínimo de 5 W

O amplificador GaN cobre 100–18000 MHz com saída saturada mínima de 5 W e típica de 7 W. O ganho é mínimo de 37 dB e típico de 38 dB, com planicidade típica de ±0.5 dB.

Frequência de operação: Símbolo: BW; Mínimo: 100; Máximo: 18000; Unidade: MHz

Potência de saída RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Mínimo: 5; Típico: 7; Unidade: W

Ganho de potência @ PSAT: Símbolo: Gp; Mínimo: 37; Típico: 38; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência @ PSAT: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.5; Unidade: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCPAM-10700-12700-100

Amplificador de potência GaN RF de 10700–12700 MHz, típico de 100 W

O amplificador GaN cobre 10700–12700 MHz com saída saturada típica de 100 W e ganho típico de 50 dB. A planicidade típica é ±1 dB, com harmônicos típicos −50 dBc a 100 W de saída.

Frequência de operação: Símbolo: BW; Mínimo: 10700; Máximo: 12700; Unidade: MHz

Potência de saída RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Típico: 100; Unidade: W

Ganho de potência @ PSAT: Símbolo: Gp; Típico: 50; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência @ PSAT: Símbolo: ΔGp; Típico: ±1; Unidade: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω. Confirme com a LCRF a corrente de operação e a atuação da proteção contra sobrecorrente antes de dimensionar a fonte de alimentação.

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCPAM-10700-12700-50

Amplificador de potência GaN RF de 10700–12700 MHz, típico de 50 W

O amplificador GaN fornece saída saturada típica de 50 W em 10700–12700 MHz e ganho típico de 47 dB. A corrente dinâmica típica é 10 A a 50 W, com corrente de repouso típica de 1.6 A.

Frequência de operação: Símbolo: BW; Mínimo: 10700; Máximo: 12700; Unidade: MHz

Potência de saída RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Típico: 50; Unidade: W

Ganho de potência @ PSAT: Símbolo: Gp; Típico: 47; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência @ PSAT: Símbolo: ΔGp; Típico: ±1; Unidade: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCPAM-10700-12750-100

Amplificador GaN RF de 10700–12750 MHz, típico de 100 W, adaptador WR75

O amplificador GaN cobre 10700–12750 MHz com saída saturada típica de 100 W e ganho mínimo de 50 dB. A saída típica na compressão de 1 dB é 40 W; a corrente típica é 21 A a 100 W.

Frequência de operação: Símbolo: BW; Mínimo: 10700; Máximo: 12750; Unidade: MHz

Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P-1dB; Típico: 40; Unidade: W

Potência de saída RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Típico: 100; Unidade: W

Ganho de potência @ PSAT: Símbolo: Gp; Mínimo: 50; Unidade: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCPAM-2000-6000-20

Amplificador GaN RF de 2000–6000 MHz, saída saturada típica de 25 W

A ficha deste modelo especifica saída saturada típica de 25 W em 2000–6000 MHz e ganho típico de 44 dB. A corrente típica de 2.5 A e a eficiência de potência adicionada de 30% são ambas especificadas a 20 W de saída.

Frequência de operação: Símbolo: BW; Mínimo: 2000; Máximo: 6000; Unidade: MHz

Potência de saída RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Típico: 25; Unidade: W

Ganho de potência @ PSAT: Símbolo: Gp; Típico: 44; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência @ PSAT: Símbolo: ΔGp; Típico: ±1; Unidade: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCPAM-20-520-200A

Módulo amplificador de potência RF LDMOS de 20–520 MHz, 200 W saturados

O módulo com estágio final LDMOS cobre 20–520 MHz com potência saturada típica de 200 W. A saída no ponto de compressão de 1 dB é especificada separadamente em 50 W típicos, com ganho de pequenos sinais típico de 53 dB.

Frequência de operação: Símbolo: BW; Mínimo: 20; Máximo: 520; Unidade: MHz

Potência RF de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 200; Unidade: W

Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 50; Unidade: W

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: G; Típico: 53; Unidade: dB

25 °C; 50 Ω

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCPAM-20-520-350

Amplificador LDMOS RF de 20–520 MHz, saída saturada típica de 350 W

O amplificador LDMOS cobre 20–520 MHz com saída saturada típica de 350 W e saída típica de 150 W na compressão de 1 dB. O ganho típico é 56 dB, a corrente 29 A a 350 W e a alimentação típica 48 VDC.

Frequência de operação: Símbolo: BW; Mínimo: 20; Máximo: 520; Unidade: MHz

Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P-1dB; Típico: 150; Unidade: W

Potência de saída RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Típico: 350; Unidade: W

Ganho de potência @ PSAT: Símbolo: Gp; Típico: 56; Unidade: dB

+48.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCPAM-3000-8000-100-485

Amplificador de potência GaN RF de 3000–8000 MHz, típico de 100 W, RS-485

O amplificador GaN cobre 3000–8000 MHz com saída saturada mínima de 80 W e típica de 100 W. O ganho é mínimo de 49 dB e típico de 50 dB; a corrente típica é 18 A a 100 W de saída.

Frequência de operação: Símbolo: BW; Mínimo: 3000; Máximo: 8000; Unidade: MHz

Potência de saída RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Mínimo: 80; Típico: 100; Unidade: W

Ganho de potência @ PSAT: Símbolo: Gp; Mínimo: 49; Típico: 50; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência @ PSAT: Símbolo: ΔGp; Típico: ±2; Unidade: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCPAM-30-1000-10

Amplificador de potência GaN RF de 30–1000 MHz, típico de 10 W

O amplificador GaN cobre 30–1000 MHz com saída saturada mínima de 9 W e típica de 10 W. O ganho típico é 40 dB com planicidade ±1 dB; a corrente típica é 0.6 A a 10 W de saída.

Frequência de operação: Símbolo: BW; Mínimo: 30; Máximo: 1000; Unidade: MHz

Potência de saída RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Mínimo: 9; Típico: 10; Unidade: W

Ganho de potência @ PSAT: Símbolo: Gp; Típico: 40; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência @ PSAT: Símbolo: ΔGp; Típico: ±1; Unidade: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCPAM-30-1500-1

Amplificador de potência GaN RF de 30–1500 MHz, mínimo de 1 W

O módulo especifica saída saturada mínima de 1 W e ganho mínimo de 30 dB em 30–1500 MHz. A corrente típica é 0.15 A a 1 W, com planicidade típica de ganho de ±1 dB.

Frequência de operação: Símbolo: BW; Mínimo: 30; Máximo: 1500; Unidade: MHz

Potência de saída RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Mínimo: 1; Unidade: W

Ganho de potência @ PSAT: Símbolo: Gp; Mínimo: 30; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência @ PSAT: Símbolo: ΔGp; Típico: ±1; Unidade: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCPAM-30-2000-1

Amplificador de potência GaN RF de 30–2000 MHz, mínimo de 1 W

Este modelo cobre 30–2000 MHz conforme a tabela elétrica, com saída saturada mínima de 1 W e ganho mínimo de 30 dB. Os harmônicos típicos são −12 dBc a 1 W e os sinais espúrios típicos −60 dBc em saturação.

Frequência de operação: Símbolo: BW; Mínimo: 30; Máximo: 2000; Unidade: MHz

Potência de saída RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Mínimo: 1; Unidade: W

Ganho de potência @ PSAT: Símbolo: Gp; Mínimo: 30; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência @ PSAT: Símbolo: ΔGp; Típico: ±1; Unidade: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCPAM-5000-6000-100

Módulo amplificador de potência RF GaN, 5–6 GHz, ≥100 W

LCPAM-5000-6000-100 é especificado para saída saturada mínima de 100 W e ganho mínimo de 50 dB em PSAT na faixa de 5–6 GHz, a 28 VDC, 25 °C e 50 Ω.

Frequência de operação: Símbolo: BW; Mínimo: 5000; Máximo: 6000; Unidade: MHz

Potência RF de saída saturada: Símbolo: PSAT; Mínimo: 100; Unidade: W; PSAT

Ganho de potência (PSAT): Símbolo: Gp; Mínimo: 50; Unidade: dB; PSAT

Planicidade do ganho de potência (PSAT): Símbolo: ΔGp; Típico: ±1; Unidade: dB; PSAT

28 VDC; 25 °C; 50 Ω

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCPAM-5000-8500-25

Amplificador de potência GaN RF de 5000–8500 MHz, típico de 25 W

O amplificador GaN cobre 5000–8500 MHz com saída saturada mínima de 20 W e típica de 25 W. O ganho é mínimo de 43 dB e típico de 44 dB; os harmônicos típicos são −40 dBc a 20 W.

Frequência de operação: Símbolo: BW; Mínimo: 5000; Máximo: 8500; Unidade: MHz

Potência de saída RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Mínimo: 20; Típico: 25; Unidade: W

Ganho de potência @ PSAT: Símbolo: Gp; Mínimo: 43; Típico: 44; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência @ PSAT: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.5; Unidade: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCPAM-500-2500-100A

Amplificador de potência GaN RF de 500–2500 MHz, típico de 100 W, variante A

A variante A GaN cobre 500–2500 MHz com saída saturada típica de 100 W e ganho típico de 50 dB. A corrente típica é 12 A a 100 W; a medição de harmônicos mantém a condição de saída a 70 W.

Frequência de operação: Símbolo: BW; Mínimo: 500; Máximo: 2500; Unidade: MHz

Potência de saída RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Típico: 100; Unidade: W

Ganho de potência @ PSAT: Símbolo: Gp; Típico: 50; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência @ PSAT: Símbolo: ΔGp; Típico: ±2; Unidade: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω A tabela elétrica informa 26 VDC mínimo, 28 VDC típico e 30 VDC máximo, enquanto a linha A1 VDD informa 28–32 VDC. A alegação de faixa para A1 não é publicada. Confirme a faixa permitida e a ligação de A1 antes de alimentar; 32 VDC não é aqui um máximo operacional aceito.

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCPAM-6000-18000-50

Amplificador de potência RF de estado sólido de 6–18 GHz, típico de 50 W

O amplificador de estado sólido cobre 6–18 GHz com saída saturada mínima de 45 W e típica de 50 W sob entrada 0 dBm. O ganho típico é 47 dB; a planicidade é típica ±1.5 dB e máxima ±2.5 dB na mesma condição de entrada.

Frequência de operação: Símbolo: BW; Mínimo: 6; Máximo: 18; Unidade: GHz

Potência RF de saída saturada @ Pin = 0 dBm: Símbolo: Psat; Mínimo: 45; Típico: 50; Unidade: W

Ganho de potência @ Pin = 0 dBm: Símbolo: Gp; Típico: 47; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência @ Pin = 0 dBm: Símbolo: ΔGp; Típico: ±1.5; Máximo: ±2.5; Unidade: dB

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCPAM-6000-8500-20

Amplificador de potência GaN RF de 6000–8500 MHz, mínimo de 20 W

A ficha deste modelo especifica saída saturada mínima de 20 W e típica de 25 W em 6000–8500 MHz. A corrente típica de 2.5 A e eficiência de potência adicionada de 30% aplicam-se a 20 W; a corrente de repouso típica é 1.8 A.

Frequência de operação: Símbolo: BW; Mínimo: 6000; Máximo: 8500; Unidade: MHz

Potência de saída RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Mínimo: 20; Típico: 25; Unidade: W

Ganho de potência @ PSAT: Símbolo: Gp; Mínimo: 43; Típico: 44; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência @ PSAT: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.5; Unidade: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCPAM-6000-8500-25

Amplificador de potência GaN RF de 6000–8500 MHz, típico de 25 W

Este modelo especifica saída saturada típica de 25 W e mínima de 20 W em 6000–8500 MHz. O ganho é típico de 44 dB e mínimo de 43 dB, com planicidade típica de ±0.5 dB.

Frequência de operação: Símbolo: BW; Mínimo: 6000; Máximo: 8500; Unidade: MHz

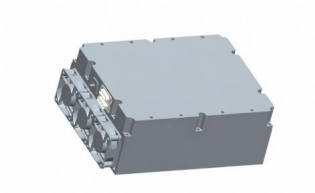
Potência de saída RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Mínimo: 20; Típico: 25; Unidade: W

Ganho de potência @ PSAT: Símbolo: Gp; Mínimo: 43; Típico: 44; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência @ PSAT: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.5; Unidade: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCPAM-8000-12000-100

Amplificador de potência GaN RF de 8000–12000 MHz, típico de 100 W

O amplificador GaN cobre 8000–12000 MHz com saída saturada típica de 100 W e ganho mínimo de 53 dB. A saída típica na compressão de 1 dB é 20 W, com planicidade típica de ±1.5 dB.

Frequência de operação: Símbolo: BW; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Unidade: MHz

Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P-1dB; Típico: 20; Unidade: W

Potência de saída RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Típico: 100; Unidade: W

Ganho de potência @ PSAT: Símbolo: Gp; Mínimo: 53; Unidade: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCPAS-8000-12000-200

Sistema amplificador de potência GaN RF de 8000–12000 MHz, típico de 200 W

O sistema GaN cobre 8000–12000 MHz com saída saturada típica de 200 W e saída típica de 40 W na compressão de 1 dB. O ganho é mínimo de 53 dB com planicidade típica de ±1.5 dB.

Frequência de operação: Símbolo: BW; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Unidade: MHz

Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P-1dB; Típico: 40; Unidade: W

Potência de saída RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Típico: 200; Unidade: W

Ganho de potência @ PSAT: Símbolo: Gp; Mínimo: 53; Unidade: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCPAS-8000-12000-400

Sistema amplificador de potência GaN RF de 8000–12000 MHz, típico de 400 W

O sistema GaN especifica saída saturada típica de 400 W em 8000–12000 MHz e saída típica de 120 W na compressão de 1 dB. O ganho é mínimo de 56 dB com planicidade típica de ±1.5 dB.

Frequência de operação: Símbolo: BW; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Unidade: MHz

Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P-1dB; Típico: 120; Unidade: W

Potência de saída RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Típico: 400; Unidade: W

Ganho de potência @ PSAT: Símbolo: Gp; Mínimo: 56; Unidade: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalhes do produto Ficha técnica do produto

Aviso do documento

As especificações podem ser revisadas. Antes de concluir o projeto, confirme com a LCRF a revisão vigente e os requisitos específicos do produto. A proposta aprovada e a documentação do pedido definem a configuração fornecida.